



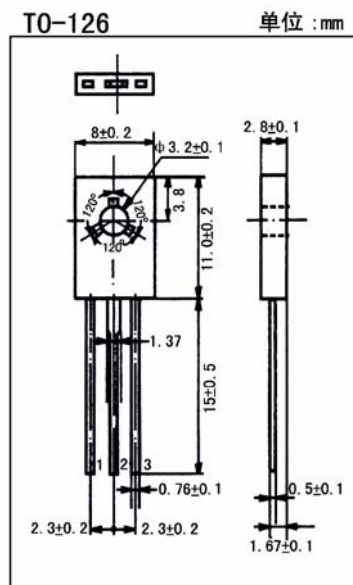
2SA715 (3CG715) 硅 PNP 半导体三极管/SILICON PNP TRANSISTOR

用途:用于低频功率放大/Purpose: Low frequency power amplifier applications.

特点:与 2SC1162 (3DA1162) 互补/Features: Complementary pair with 2SC1162 (3DA1162).

极限参数/Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	-35	V
V_{CE0}	-35	V
V_{EB0}	-5.0	V
I_C	-2.5	A
I_{CP}	-3.0	A
P_C (Ta=25°C)	750	mW
P_C (Tc=25°C)	10	W
T_j	150	°C
T_{stg}	-55~150	°C



引脚: 1. E 2. C 3. B

电性能参数/Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数符号 Symbol	测试条件 Test Condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C = -1.0\text{mA}$	$I_E = 0$	-35			V
V_{CE0}	$I_C = -10\text{mA}$	$R_{BE} = \infty$	-35			V
V_{EB0}	$I_E = -1.0\text{mA}$	$I_C = 0$	-5.0			V
I_{CB0}	$V_{CB} = -35\text{V}$	$I_E = 0$			-20	μA
$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -2.0\text{V}$	$I_C = -0.5\text{A}$	60		320	
$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -2.0\text{V}$	$I_C = -1.5\text{A}$	20			
V_{BE}	$V_{CE} = -2.0\text{V}$	$I_C = -1.5\text{A}$		-1.0	-1.5	V
$V_{CE(sat)}$	$I_C = -2.0\text{A}$	$I_B = -0.2\text{A}$		-0.5	-1.0	V
f_T	$V_{CE} = -2.0\text{V}$	$I_C = -0.2\text{A}$		160		MHz

h_{FE} 分档/ h_{FE} Classifications: B:60~120 C:100~200 D:160~320

2SA715 (3CG715)

